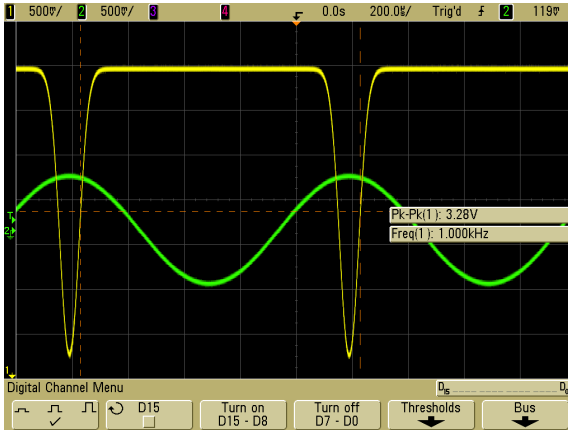


- Transistor hier als Schalter, da Strom nur fließt, wenn $U_{CE} \neq 0$
- Sobald der Schalter in der ersten Schaltung geschlossen ist, liegt an Collector und Emitter eine Spannung an und der Transistor lässt durch \Rightarrow iode leuchtet
- Jetzt liegt konstante Spannung an Kollektor und Emitter \Rightarrow Transistor sperrt nicht und Diode leuchtet
- Schaltung

Funktionsweise der Schaltung

- Bei positiver Eingangsspannung $> 0.7V$ leitet die Basis-Emitter-Strecke des Transistors
- Je größer die Eingangsspannung, desto größer ist $I_{BE} \Rightarrow U_{CE}$, die abgegriffen wird, wird dementsprechend kleiner \Rightarrow Schaltung invertiert für Positive U_{in}
- Sobald $U_{BE} < 0.7V \Rightarrow$ Transistor sperrt und Ausgangssignal entspricht den $9V$ der Gleichspannung
- Basiswiderstand R_1 bestimmt Arbeitspunkt der Schaltung und kann zu dessen Regulierung verwendet werden

Common-Emitter



Beobachtung:

Gemessene Amplitude bei Sinusbergen der Eingangsspannung:

$$U_{out} = 3.28V$$

$$\text{Sonst: } U_{out} = 9V$$

Berechnung der Verstärkung:

Nach Vorlesung folgt:

$$U_{out} = U_{cc} - h_{FE} \cdot \frac{R_C}{R_B} \cdot (U_{in} - U_{BE}) \Rightarrow h_{FE} = \frac{(U_{cc} - U_{out})}{(U_{in} - U_{BE}) \cdot \frac{R_C}{R_B}} \quad (1)$$

Einsetzen ergibt, da $U_{in,max} = \frac{U_{pp}}{2} = 0.6V$ und $U_{BE} = 0.7V$ (Konstante für Dioden) einen negativen, betragsmäßig großen Wert $\Rightarrow U_{BE}$ muss effektiv kleiner sein als $0.7V$

Taktik:

- projiziere das Intervall, in dem $U_{out} \neq 9V$ auf das Eingangssignal (nur bei diesen Spannungen ist U_{in} größer als die Durchlassspannung)
- lese dort die Differenz von maximalen Amplitude zu Funktionswert ab

Ablesen ergibt für $\Delta t_{peak,out} = 200\mu s$: $\Delta U = (U_{in} - U_{BE}) \leq 1mV$
Für die Verstärkung ergibt sich mit $0.1V$ also:

$$h_{FE} = \dots = 3.28 \quad (2)$$

Laut Transistor-Datenblatt liegt h_{FE} zwischen 420 und 800
Daher Annahme, dass Transistor nicht unter optimalen
Bedingungen arbeitet
Und für den Gain ergibt sich:

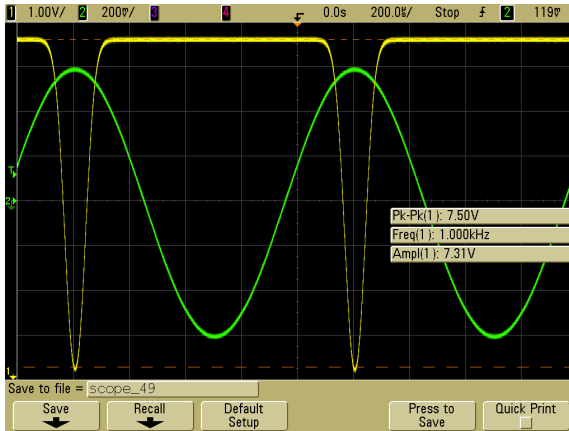
$$G = -h_{FE} \cdot \frac{R_C}{R_B} = 57.2 \quad (3)$$

Verhalten unter Erwärmung

- Bei Berührung mit dem Finger nur leichter, nicht nennenswerter Anstieg der Amplitude
- Effektiver ist das Hinhalten eines Lötkolben ($T \approx 150^\circ\text{C}$) in die Nähe des Transistors \Rightarrow Amplitude steigt auf bis zu 7.3V an

Grund: Leitfähigkeit des Halbleiters verstärkt sich bei höheren Temperaturen

Common-Emitter

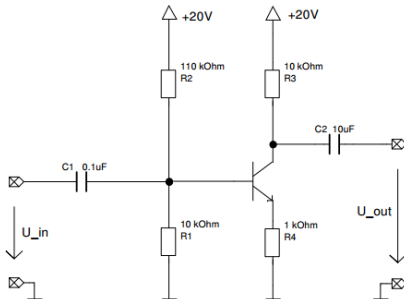


Eigenschaften der Schaltung:

- Nicht Linear
- Spannungen unter $\approx 0.5V$ werden abgeschnitten \Rightarrow DC-Offset in Spannung nötig, um Signal nur zu verstärken und nicht zu verändern
- Arbeitspunktbereich im Verstärkungsbereich, wenn Basis öffnet

Common-Emitter (verbessert)

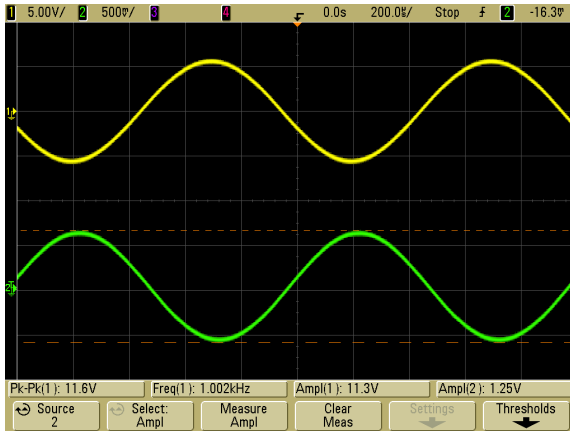
Schaltbild:



Durchführung:

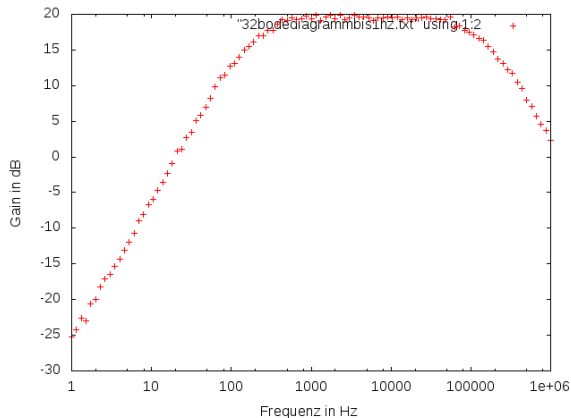
Schaltung wurde einmal mit Sinusspannung $U_{in,amp} = 1.25V$ betrieben, Ausgangssignal wurde invertiert(siehe nächste Folie), aber sonst nicht wesentlich verändert, mit $U_{out,amp} = 11.3V \Rightarrow$ Amplitudenverstärkung ≈ 9

Common-Emitter (verbessert)

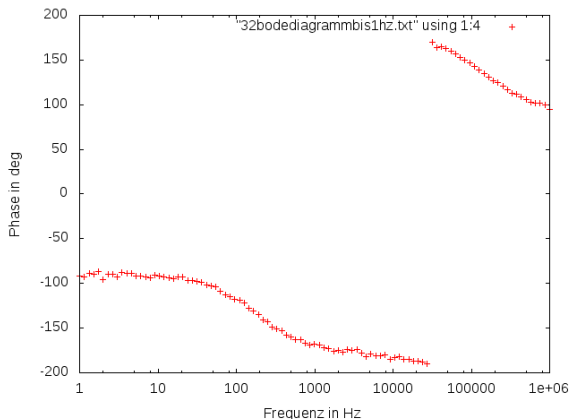


- Arbeitspunkt einer Schaltung ist die Ausgangsspannung, die ohne Eingangssignal gemessen wird
- Ausgangssignal kann nicht mehr abgeschnitten werden

Common-Emitter (verbessert)

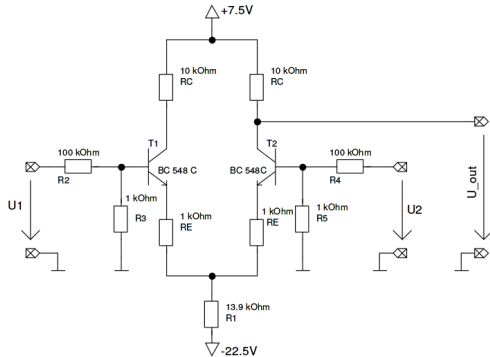


(Gain-)Bodediagramm des verbesserten CE



Phasen-Teil des Bode-Diagramms

Schaltbild:



Durchführung:

Schaltung wurde mit verschiedenen Gleich/Gegentaktspannungen betrieben, die Ausgangsspannungen wurden dann gemessen

Eigenschaften und Funktionsweise der Schaltung

- Zwei symmetrisch aufgebaute CE-Schaltungen, über den Emitter-Widerstand verbunden